

2SD1076, 2SD1076L

シリコン NPN エピタキシャル LTP 形

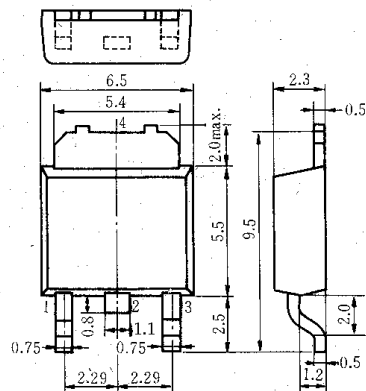
低周波電力増幅用

2SB836, 2SB836Lとコンプリメンタリペア

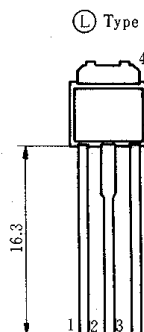
SILICON NPN EPITAXIAL LTP

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER

Complementary pair with 2SB836 and 2SB836L



(DPAK)



- ① Type
1. ベース: Base
 2. コレクタ: Collector
 3. エミッタ: Emitter
 4. コレクタ: Collector
- (Dimensions in mm)

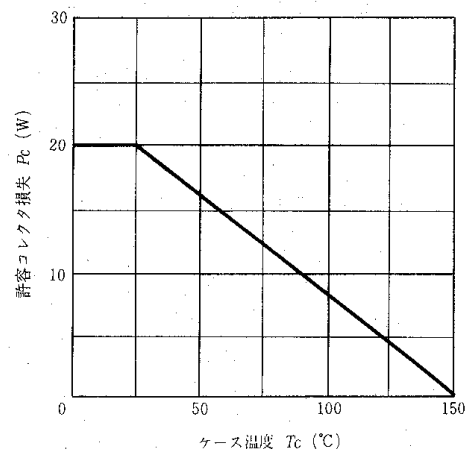
■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	2SD1076/①	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	25	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	25	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	5	V
コレクタ電流	I_C	2.5	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$	3	A
許容コレクタ損失	P_C^*	20	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

* $T_C=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_C=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CB0}$	$I_C=1\text{mA}, I_E=0$	25	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_C=10\text{mA}, R_{BE}=\infty$	25	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E=1\text{mA}, I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CB0}	$V_{CB}=25\text{V}, I_E=0$	—	—	20	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=1.5\text{A}^*$	20	—	—	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=1.5\text{A}$	—	0.93	1.5	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2\text{A}, I_B=0.2\text{A}$	—	0.5	1.0	V

*パルス測定

* Pulse Test